



TALOS F200S G2 : Caractéristiques et performances

S-FEG (canon à émission de champ) 200 kV

Limite d'information : 0.11 nm

Résolution STEM : 0.16 nm

Résolution EDS @ 10 kcps : 130 eV (Mn-Ka)

Porte-objet double-inclinaison THERMOFISHER

Module STEM + détecteur HAADF (sonde 1 nm)

Caméra de survol : FluCam CCD

Caméra Haute Rés. CETA 16M : 4096 × 4096 pixels²

Matériaux étudiés :

Massifs, films, poudres, conducteurs, isolants,
polymères, semiconducteurs.

Imagerie Multi-échelle et Haute Résolution

Contraste de diffraction, champ clair, champ
sombre, champ sombre conique, faisceaux
faibles.

Etude fine de microstructures de défauts
(dislocations, fautes d'empilement, macles)

Contraste de phase.

Imagerie Chimique I : STEM - HAADF

Contraste de numéro atomique et de masse
par détection annulaire d'électrons diffusés à
grand angle en champ sombre.

Imagerie haute résolution STEM.

Diffraction

Diffraction en aire sélectionnée

Nano-diffraction

Diffraction en faisceau convergent.

Imagerie Chimique II : EDS SUPER-X

Spectrométrie qualitative et quantitative des
rayons X par dispersion d'énergie (EDS) et
cartographie chimique X par élément.

Personne à contacter : Dominique Eyidi